

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
25. März 2004 (25.03.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/025747 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 51/20**

[AT/DE]; Eichenweg 8, 91054 Erlangen (DE). HAUCH,
Jens [DE/DE]; Dreibergstr. 74, 91056 Erlangen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE2003/002930**

(74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT**; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
3. September 2003 (03.09.2003)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CN, JP, US.

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(30) Angaben zur Priorität:
102 41 204.9 5. September 2002 (05.09.2002) **DE**

Veröffentlicht:
— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

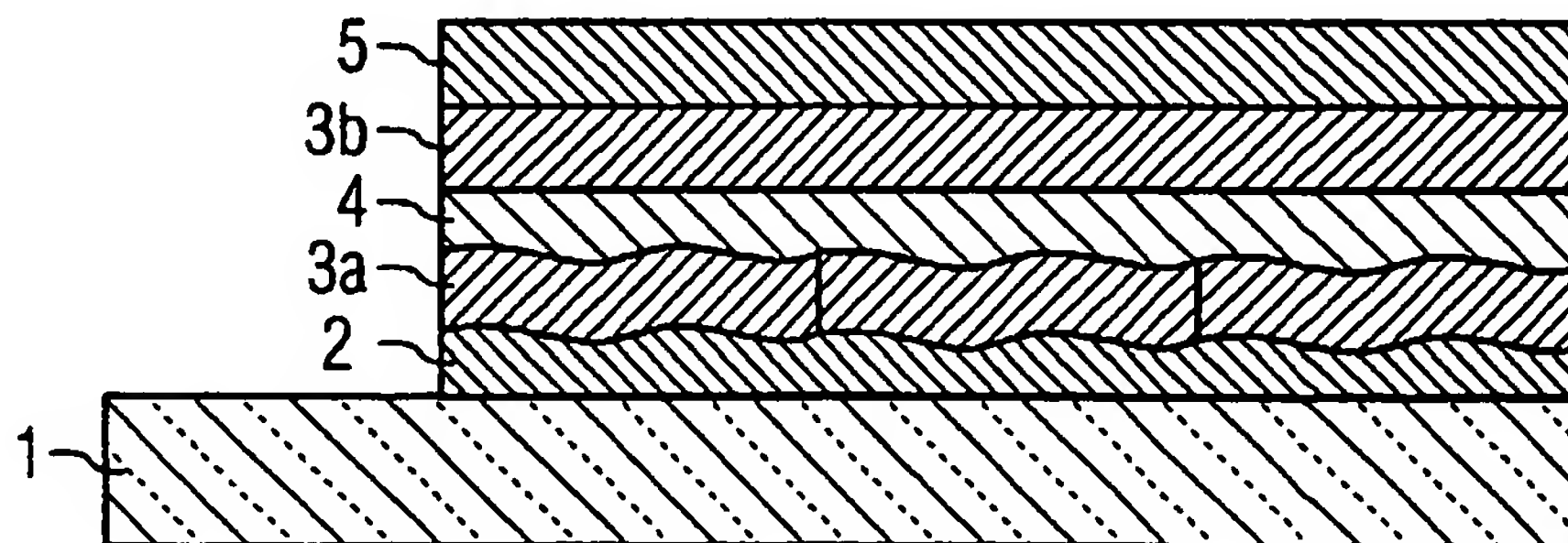
Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BRABEC, Christoph**

(54) Title: **ORGANIC PHOTOVOLTAIC COMPONENT AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF**

(54) Bezeichnung: **ORGANISCHES PHOTOVOLTAISCHES BAUELEMENT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU**



(57) Abstract: The invention relates to an organic photovoltaic component, in particular an organic solar cell, in which one or more layers is (are) structured.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches photovoltaisches Bauelement, insbesondere eine organische Solarzelle, bei der eine oder mehrere Schichten strukturiert ist(sind).

WO 2004/025747 A2

Beschreibung

Organisches photovoltaisches Bauelement und Herstellungsverfahren dazu

5

Die Erfindung betrifft ein organisches photovoltaisches Bauelement, insbesondere eine organische Solarzelle.

10 Bekannt sind Solarzellen, beispielsweise mit folgendem Zellaufbau:

Auf einem Substrat befindet sich eine positive Elektrode (typischerweise ITO, Indium Tin Oxide). Darauf befindet sich die Lochleitschicht, die beispielsweise aus PEDOT mit PSS als
15 Anion besteht. Die angrenzende Schicht ist ein Absorber, in der Regel ein organischer Halbleiter (z. B. eine Mischung aus konjugiertem Polymer mit Fulleren). Daran schließt die negative Elektrode (z. B. Ca/Ag oder LiF/Al) an. Die einzelnen Schichten können jedoch abweichen, insbesondere die Elektroden, das konjugierte Polymer und auch der Akzeptor (PCBM, ein
20 lösliches Methanofullerene).

Durch die geringe Beweglichkeit der typischerweise in diesen Solarzellen verwendeten Halbleitermaterialien wird die aktive
25 Halbleiterschicht (der Absorber) sehr dünn (typischerweise zwischen 20 nm und 2000 nm) ausgeführt, um Rekombination zu vermeiden. Diese dünne Absorberschicht reicht jedoch in der Regel nicht aus, um das eingestrahlte Licht vollständig zu absorbieren. Ein Teil des Lichts wird deshalb an der Rückelektrode verloren (absorbiert) oder reflektiert (und durch
30 die Frontseite der Solarzelle wieder ausgekoppelt).

Aufgabe der Erfindung ist es daher, diese Verlustprozesse durch einen möglichst einfachen und kostengünstigen Prozessschritt zu vermindern.
35

Gegenstand der Erfindung ist ein organisches photovoltaisches Bauelement, ein Substrat, eine positive Elektrode, einen organischen Halbleiter und eine negative Elektrode umfassend, wobei das Substrat und/oder eine oder mehrere zusätzliche Transportschicht(en) zwischen der Elektrode und der Halbleiterschicht strukturiert ist(sind). Außerdem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Strukturierung der Halbleiterschicht eines photovoltaischen Bauelements, durch Beibehaltung einer bestehenden Strukturierung einer unteren Schicht, auf die die Halbleiterschicht aufgebracht wird.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung ist das Substrat strukturiert, so dass die Elektrode und die Halbleiterschicht der Strukturierung folgen und damit die spezifische Absorption der Halbleiterschicht erhöht wird.

Nach einer anderen Ausführungsform wird die Halbleiterschicht so aufgetragen, dass sie die Strukturierung planarisiert.

20 Nach einer Ausführungsform werden mehrere Schichten, die unterhalb der Halbleiterschicht liegen, strukturiert. Es können auch Zwischenschichten in das photovoltaische Bauelement eingebaut werden, damit eine strukturierte Oberfläche vorliegt, auf die die Halbleiterschicht aufgebracht wird.

25

Die Strukturierung einer oder mehrerer Schichten des photovoltaischen Elements führt dazu, dass Licht in die Solarzelle besser einkoppelt. Deshalb wird diese Art der Strukturierung auch „Lighttrapping“ genannt.

30

Der Begriff „organisches Material“ und/oder „Funktionspolymer“ umfasst hier alle Arten von organischen, metallorganischen und/oder anorganischen Kunststoffen, die im Englischen z.B. mit „plastics“ bezeichnet werden. Es handelt sich um alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der Halbleiter, die die klassischen Dioden bilden (Germanium, Silizium), und der typischen metallischen Leiter. Eine Beschränkung im dogmati-

schen Sinn auf organisches Material als Kohlenstoff-
enthaltendes Material ist demnach nicht vorgesehen, vielmehr
ist auch an den breiten Einsatz von z.B. Siliconen gedacht.
Weiterhin soll der Term keiner Beschränkung im Hinblick auf
5 die Molekülgröße, insbesondere auf polymere und/oder oligome-
re Materialien unterliegen, sondern es ist durchaus auch der
Einsatz von „small molecules“ möglich.

Generell wird Lighttrapping durch eine periodische Strukturi-
10 rierung zumindest einer der Schichten der Solarzelle er-
reicht. Es wurde zwar schon vorgeschlagen (M. Niggeman et
al., „Trapping Light in organic plastic solar cells with in-
tegrated diffraction gratings“, Proceedings of the World Pho-
tovoltaic Congress, Munich 2001), den Absorber (zum Beispiel
15 durch einen Prägeprozess, Stempelprozess) periodisch zu
strukturieren. Die Prägung des Halbleiters ist jedoch ein
kritischer Prozessschritt, da bei diesem Prozess die sensible
Halbleiterschicht leicht beschädigt werden kann. Trotzdem
kann die Strukturierung der Halbleiterschicht in Kombination
20 mit der Strukturierung des Substrats und/oder einer zusätzli-
chen Transportschicht im Sinne der Erfindung durchgeführt
werden.

Die Begriffe die obere Schicht „folgt der Strukturierung“
25 und/oder „bildet die Strukturierung nach oben hin ab“ be-
schreibt nur die Tatsache, dass zumindest ein Teil der unter-
en Strukturierung nach oben hin durchgepaust wird, also ent-
weder die untere Strukturierung teilweise oder ganz oben wie-
derzufinden ist. Dabei kann die obere Struktur durchaus auch
30 noch Ergänzungen der Strukturierung erfahren, so dass sich
eine gänzlich andere Struktur ergibt. Die Erfindung soll an
dieser Stelle in keiner Weise beschränkt sein.

Im folgenden wird die Erfindung noch anhand einzelner Bei-
35 spiele, die Ausführungsformen der Erfindung betreffen, näher
erläutert.

Figur 1 zeigt einen Schichtaufbau eines photovoltaischen Bauelements, bei dem das Substrat strukturiert ist und mit einer zusätzlichen Transportschicht wieder planarisiert wird und die untere Elektrode bereits wieder auf eine planare Oberfläche aufgetragen wird.

Figur 2 zeigt ein photovoltaisches Bauelement, bei dem auf dem Substrat eine zusätzliche Ausgleichsschicht zur Anpassung der optischen Eigenschaften (matching layer) so aufgebracht ist, dass die Strukturierung nach oben hin abgebildet wird, eine Strukturierung der Elektrodenschicht bewirkt, die dann durch eine Lochleitschicht planarisiert wird, so dass die Halbleiterschicht auf eine planare Oberfläche aufgebracht wird.

Figur 3 zeigt ein photovoltaisches Bauelement, bei dem auf einem planarem Substrat eine untere Elektrode strukturiert wird, die Strukturierung durch eine Lochleitschicht durchwirkt und schließlich die Halbleiterschicht auf eine strukturierte Oberfläche aufgebracht wird.

In Figur 1 erkennt man das Substrat 1, das eine PET Folie oder auch eine Photolackschicht auf Glas sein kann. Dieses Substrat wird strukturiert und durch eine zusätzliche Schicht 6, beispielsweise eines Materials mit hohem Brechungsindex, wie TiO_2 , beschichtet, so dass sich die Struktur durchpaust und dann wieder mit einer Schicht 7 eines transparenten Materials, das auch eine PET Folie oder eine Photolackschicht auf Glas sein kann, planarisiert. Auf diesem Substrat wird dann die Standardzelle prozessiert, von unten nach oben als erstes eine untere Elektrode 2, die für den Fall, dass die Seite des Substrats 1 die lichteinfallende Seite des photovoltaischen Bauelements darstellt, semitransparent (z.B. ITO) ausgestaltet ist. Darauf befindet sich bei dieser Ausführungsform eine zusätzliche organische Elektrode 3a, beispielsweise aus PEDOT und darauf die Halbleiterschicht 4, eine zweite Elektrode 3b und/oder 5.

Figur 2 zeigt ein Substrat 1, das strukturiert ist und auf dem eine Schicht 6 eines Materials mit beispielsweise hohem Brechungsindex aufgebracht ist, das der Strukturierung folgt. Darauf befindet sich die untere Elektrode 2, darauf eine zusätzliche Elektrode oder Transportschicht 3a, die die Strukturierung planarisiert. Die Halbleiterschicht 4 ist auf eine planare Oberfläche aufgebracht. Der weitere Aufbau umfasst eine weitere Elektrode oder Transportschicht 3b und die obere Elektrode 5.

Das Material der Schicht 6 ist allgemein eine Schicht für verbesserte optische Eigenschaften und/oder optische Anpassung, wie zum Beispiel eine Schicht mit hohem Brechungsindex.

Figur 3 zeigt ein Substrat 1, das nicht strukturiert ist, darauf eine untere Elektrode 2, die strukturiert ist, darauf eine zusätzliche Schicht 3a, die der Strukturierung folgt und auf deren strukturierter Oberfläche die Halbleiterschicht 4 aufgebracht wird. Die Halbleiterschicht 4 planarisiert die Strukturierung, so dass eine zusätzliche Elektrode 3b auf eine planare Oberfläche der Halbleiterschicht 4 aufgebracht wird. Eine weitere Elektrode 3b und die obere Elektrode 5 sind bei der gezeigten Ausführung nicht strukturiert.

Für den Fall, dass die untere Elektrode nicht auf der lichteinfallenden Seite ist, kann diese Elektrode auch aus komplett reflektierendem Material ausgeführt sein.

Die Erfindung zeigt erstmals photovoltaische Bauelemente, deren spezifische Absorption von Licht durch die Strukturierung einer oder mehrerer Schichten des Bauelements, die zu einer verbesserten Einkopplung führen, erhöht wird. Die Strukturierung der Schichten wird dabei ohne mechanische oder thermische Belastung der Halbleiterschicht ausgeführt, so dass diese unbeschadet bleibt.

Durch die Erfindung wird vorgeschlagen, anstatt einer Strukturierung der Halbleiterschicht, die zwar eine Erhöhung der spezifischen Absorption bewirkt, jedoch die Halbleiterschicht mechanisch, chemisch und/oder physikalisch belastet, eine

5 Strukturierung des Substrates vor der Aufbringung der positiven oder negativen Elektrode und/oder eine Strukturierung einer organischen Transportschicht (z.B. PEDOT) vor Aufbringung der Halbleiterschicht. Die Strukturierungsschritte betreffen das Substrat, eine der Elektroden und/oder eine der zusätzli-

10 che(n) Transportschicht(en) aber nicht den Halbleiter, so dass dieser unbelastet bleibt.

Beispiele für strukturierbare Substrate wären Folien oder Schichten aus konventionellen Polymeren wie PET, PMMA, PC.

15 Diese Folien können typischerweise eine Schichtdicke zwischen 10 und 1000 micron haben, die Tiefe und Periode der eingepprägten periodischen Strukturierung kann im 10 - 1000 nm Bereich sein, die Tiefe von aperiodischen irregulären geprägten Strukturen kann im 1 - 500 micron Bereich sein.

20

Beispiele für Planarisierungslayer mit hohem optischen Brechungsindex wären Polyimide und/oder mit anorganischen Nanopartikel (TiO₂) gefüllte Polymere.

Patentansprüche

1. Organisches photovoltaisches Bauelement, ein Substrat, eine positive Elektrode, einen organischen Halbleiter und eine negative Elektrode umfassend, wobei das Substrat und/oder eine oder mehrere zusätzliche Transportschicht(en) zwischen der Elektrode und der Halbleiterschicht strukturiert ist (sind).
5
2. Organisches photovoltaisches Bauelement nach Anspruch 1, bei dem das Substrat eine flexible Folie ist, die strukturiert ist.
10
3. Organisches photovoltaisches Bauelement nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Substrat und/oder eine zusätzliche Schicht oberhalb oder unterhalb der Halbleiterschicht strukturiert ist.
15
4. Verfahren zur Strukturierung der Halbleiterschicht eines photovoltaischen Bauelements, durch Beibehaltung einer bestehenden Strukturierung einer unteren Schicht, auf die die Halbleiterschicht aufgebracht wird.
20
5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die Halbleiterschicht die Strukturierung der unteren Schicht(en) planarisiert.
25
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, bei dem die Strukturierung durch Einführen einer zusätzlichen Schicht erfolgt.

1/1

FIG 1

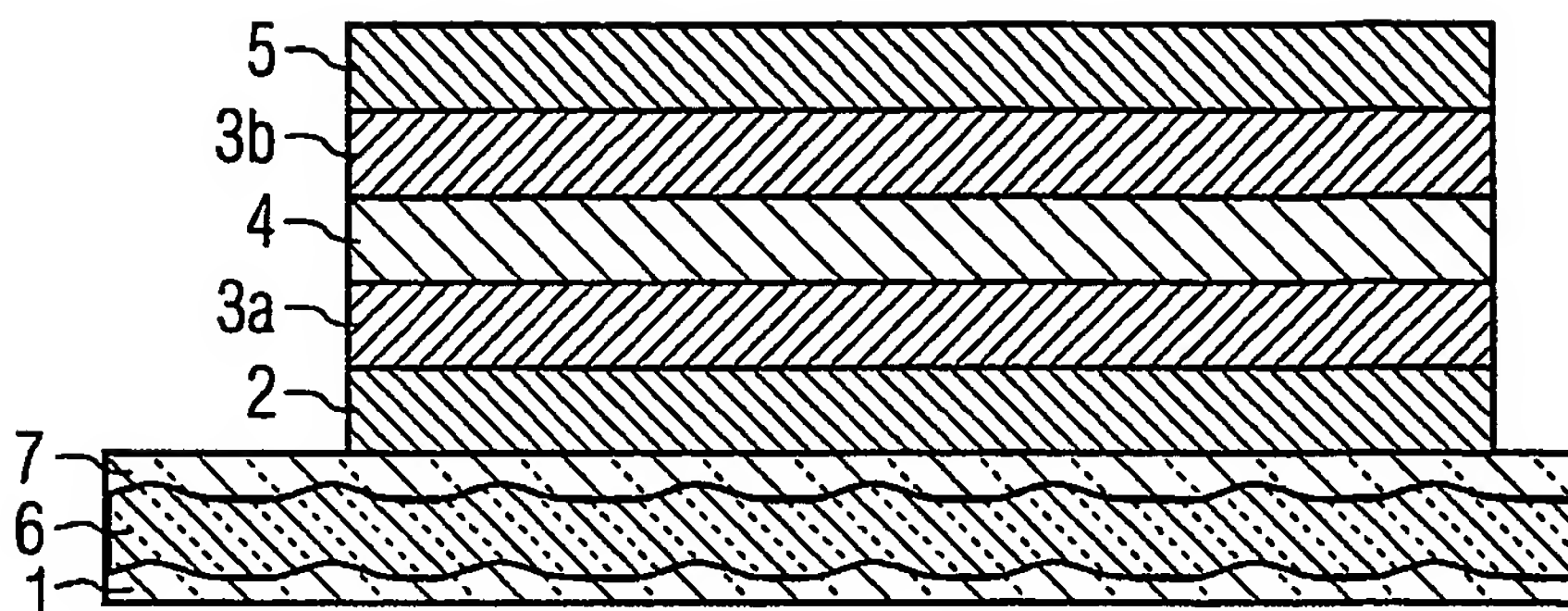


FIG 2

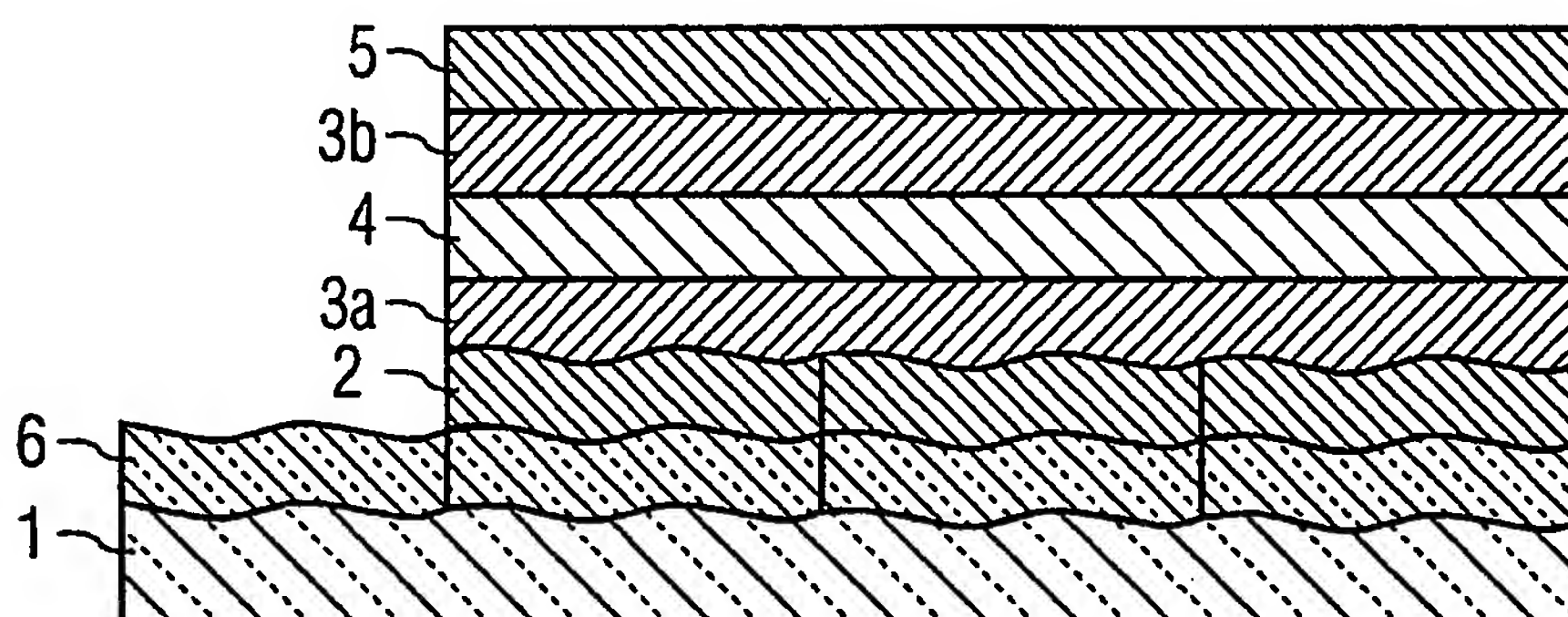
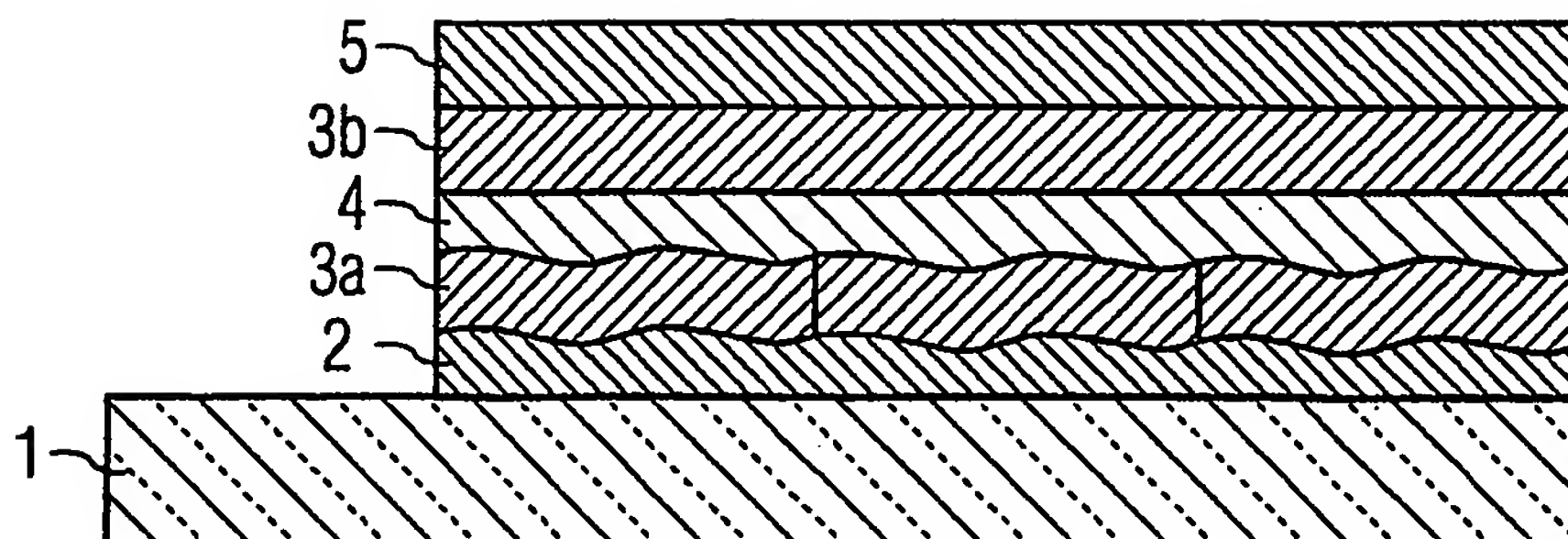


FIG 3



(12) NACH DEM VEREINBAR ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
25. März 2004 (25.03.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/025747 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 51/20**

(74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE2003/002930**

(22) Internationales Anmeldedatum:
3. September 2003 (03.09.2003)

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CN, JP, US.

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

Veröffentlicht:

(30) Angaben zur Priorität:
102 41 204.9 5. September 2002 (05.09.2002) **DE**

— mit internationalem Recherchenbericht
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 24. Juni 2004

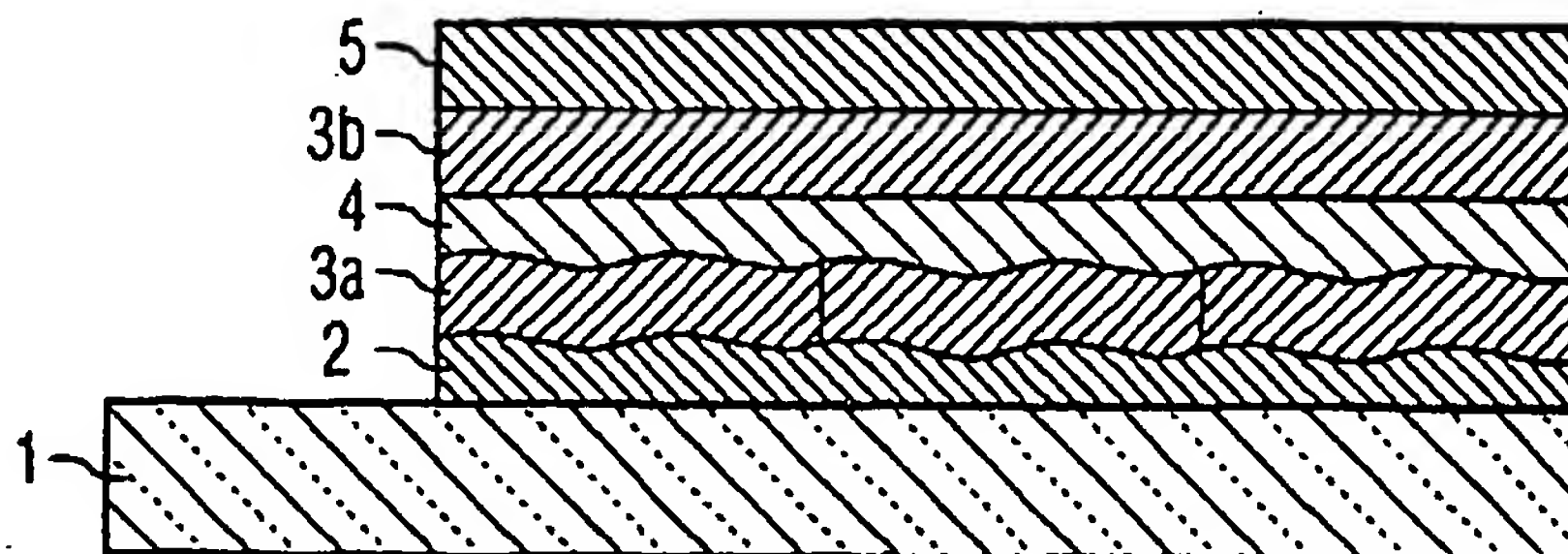
(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BRABEC, Christoph** [AT/DE]; Eichenweg 8, 91054 Erlangen (DE). **HAUCH, Jens** [DE/DE]; Dreibergstr. 74, 91056 Erlangen (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: **ORGANIC PHOTOVOLTAIC COMPONENT AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF**

(54) Bezeichnung: **ORGANISCHES PHOTOVOLTAISCHES BAUELEMENT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU**



(57) Abstract: The invention relates to an organic photovoltaic component, in particular an organic solar cell, in which one or more layers is (are) structured.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches photovoltaisches Bauelement, insbesondere eine organische Solarzelle, bei der eine oder mehrere Schichten strukturiert ist(sind).

WO 2004/025747 A3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

DE 03/02930

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L51/20

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 99/30375 A (NANOGRAM CORP) 17 June 1999 (1999-06-17) page 5, line 25 - page 13, line 30; figure 3	1,3-5
X	EP 1 213 775 A (SEIKO EPSON CORP) 12 June 2002 (2002-06-12) paragraph '0067! - paragraph '0106!	1,3-6
X	US 5 891 264 A (ARAI YASUYUKI ET AL) 6 April 1999 (1999-04-06) abstract	1,2,4,5



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

'E' earlier document but published on or after the international filing date

'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

'&' document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 April 2004

Date of mailing of the international search report

06/05/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Königstein, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

DE 03/02930

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 06, 31 July 1995 (1995-07-31) & JP 7 066438 A (TONEN CORP), 10 March 1995 (1995-03-10) abstract	1,2
A	STOLZ ROMAN L ET AL: "TRAPPING LIGHT IN POLYMER PHOTODIODES WITH SOFT EMBOSSED GRATINGS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 12, no. 3, 3 February 2000 (2000-02-03), pages 189-195, XP000923550 ISSN: 0935-9648 the whole document	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

/DE 03/02930

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9930375	A	17-06-1999	US 5986206 A	16-11-1999
			BR 9813526 A	03-10-2000
			CN 1280709 T	17-01-2001
			EP 1038326 A1	27-09-2000
			JP 2001526466 T	18-12-2001
			TW 396649 B	01-07-2000
			WO 9930375 A1	17-06-1999
EP 1213775	A	12-06-2002	JP 2003163359 A	06-06-2003
			AU 9714701 A	13-06-2002
			CN 1363959 A	14-08-2002
			EP 1213775 A2	12-06-2002
			JP 2003163360 A	06-06-2003
			TW 516242 B	01-01-2003
			US 2002108649 A1	15-08-2002
US 5891264	A	06-04-1999	JP 9069642 A	11-03-1997
			JP 3272682 B2	08-04-2002
			JP 11195798 A	21-07-1999
			US 5711824 A	27-01-1998
JP 7066438	A	10-03-1995	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
DE 03/02930

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H01L51/20

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 99/30375 A (NANOGRAM CORP) 17. Juni 1999 (1999-06-17) Seite 5, Zeile 25 - Seite 13, Zeile 30; Abbildung 3	1,3-5
X	EP 1 213 775 A (SEIKO EPSON CORP) 12. Juni 2002 (2002-06-12) Absatz '0067! - Absatz '0106!	1,3-6
X	US 5 891 264 A (ARAI YASUYUKI ET AL) 6. April 1999 (1999-04-06) Zusammenfassung	1,2,4,5
	----- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. April 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

06/05/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Königstein, C

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

/DE 03/02930

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1995, Nr. 06, 31. Juli 1995 (1995-07-31) & JP 7 066438 A (TONEN CORP), 10. März 1995 (1995-03-10) Zusammenfassung</p>	1,2
A	<p>STOLZ ROMAN L ET AL: "TRAPPING LIGHT IN POLYMER PHOTODIODES WITH SOFT EMBOSSED GRATINGS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 12, Nr. 3, 3. Februar 2000 (2000-02-03), Seiten 189-195, XP000923550 ISSN: 0935-9648 das ganze Dokument</p>	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

DE 03/02930

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9930375	A	17-06-1999	US 5986206 A	16-11-1999
			BR 9813526 A	03-10-2000
			CN 1280709 T	17-01-2001
			EP 1038326 A1	27-09-2000
			JP 2001526466 T	18-12-2001
			TW 396649 B	01-07-2000
			WO 9930375 A1	17-06-1999
EP 1213775	A	12-06-2002	JP 2003163359 A	06-06-2003
			AU 9714701 A	13-06-2002
			CN 1363959 A	14-08-2002
			EP 1213775 A2	12-06-2002
			JP 2003163360 A	06-06-2003
			TW 516242 B	01-01-2003
			US 2002108649 A1	15-08-2002
US 5891264	A	06-04-1999	JP 9069642 A	11-03-1997
			JP 3272682 B2	08-04-2002
			JP 11195798 A	21-07-1999
			US 5711824 A	27-01-1998
JP 7066438	A	10-03-1995	KEINE	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.